

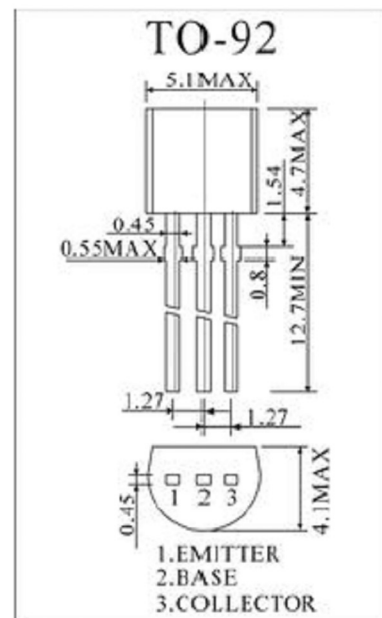
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

9012

—PNP silicon—

绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V _{CB0}	-40	V
集电极—发射极电压	V _{CE0}	-20	V
发射极—基极电压	V _{EB0}	-5	V
集电极电流	I _c	-500	mA
集电极耗散功率	P _c	600	mW
结 温	T _j	150	°C
存储温度	T _{stg}	- 55~150	°C



电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	64		300		V _{CE} = -1 V, I _c = -50 mA
集电极-基极截止电流	I _{CB0}			0.1	μ A	V _{CB} = -25 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EB0}			0.1	μ A	V _{EB} = -3 V, I _c =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	-40			V	I _c = -0.1 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CE0}	-20			V	I _c = -1 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	-5			V	I _E = -0.1 mA, I _c =0
基极-发射极电压	V _{BE(ON)}	-0.6	-0.67	-0.7	V	V _{CE} = -1 V, I _c = -10 mA
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}		-0.18	-0.6	V	I _c = -500 mA, I _B = -50 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}		-0.95	-1.2	V	I _c = -500 mA, I _B = -50 mA

h_{FE} 分档及其标志

分 档	D	E	F	G	H	I
h _{FE}	64~91	78~112	96~135	112~166	144~202	200~300